[86.03/66.25] Dispositivos Semiconductores 1er Cuatrimestre 2020

Juntura MOS

- 1. Identificación de materiales y valor de parámetros eléctricos
- 2. Distribución de carga para distintos regímenes
- 3. Curva Capacidad-Tensión

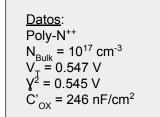
Enunciado

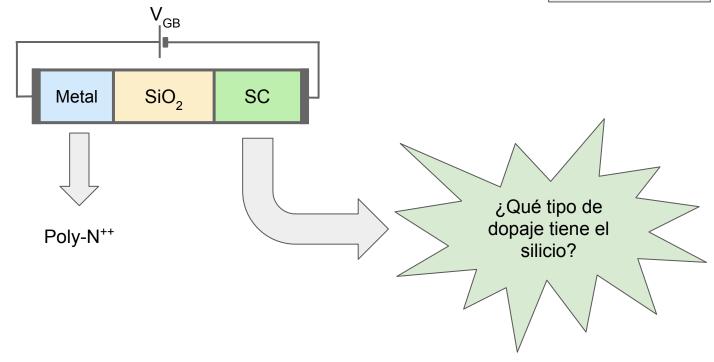
Para una estructura MOS con poly-silicio tipo N, $N_{Bulk} = 10^{17}$ cm⁻³, $V_{T} = 0.547$ V, $V_{C} = 0.545$ V y $V_{C} = 2.46$ 10^{-7} F/cm², considerando que está polarizado con: $V_{C} = \{-2V, V_{C}, 0, V_{C}, 2V\}$

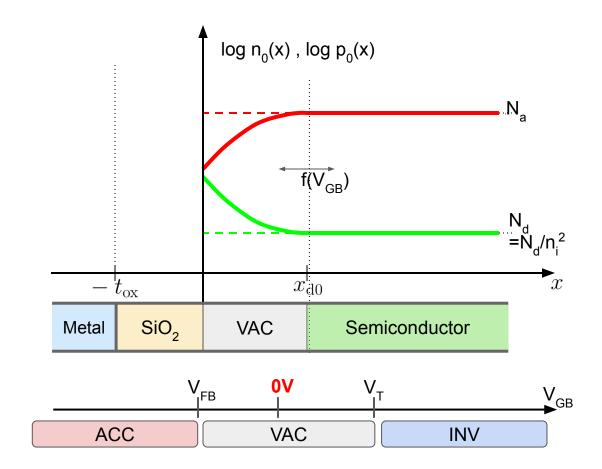
hallar

- 1. Las caídas de potencial en el óxido y en el SC, ΔV_{OX} , ΔV_{Bulk}
- 2. La carga por unidad de superficie en la interfaz poly-óxido Q'_{Poly-Ox}
- 3. La capacidad por unidad de área C'_{GB}

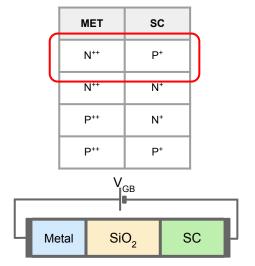
¿Cómo está compuesta la juntura?

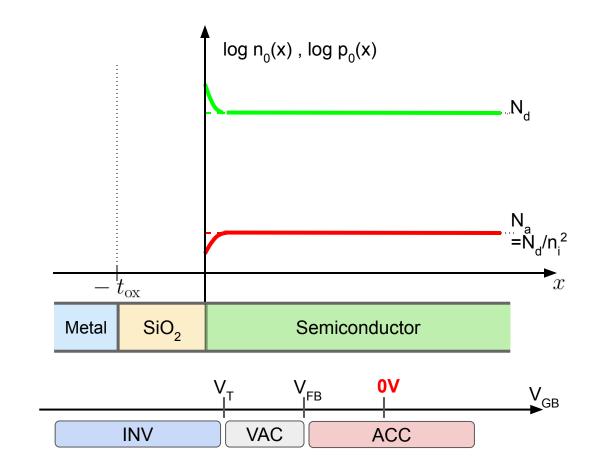




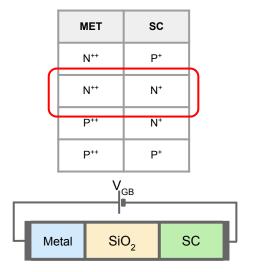


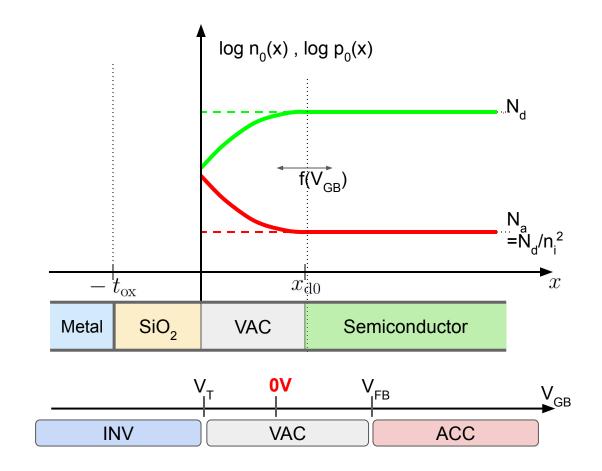
Datos: Poly-N⁺⁺ $N_{Bulk} = 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ $V_{T} = 0.547 \text{ V}$ $Y^{2} = 0.545 \text{ V}$ $C'_{OX} = 246 \text{ nF/cm}^{2}$



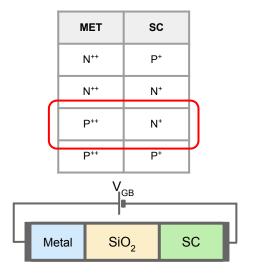


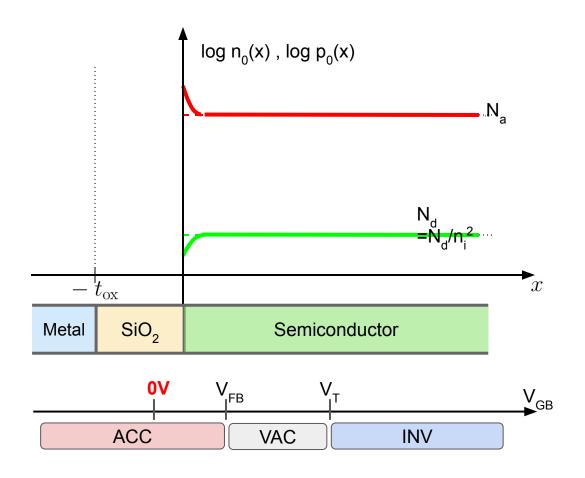
Datos: Poly-N⁺⁺ $N_{Bulk} = 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ $V_{T} = 0.547 \text{ V}$ $V_{C}'_{OX} = 246 \text{ nF/cm}^{2}$



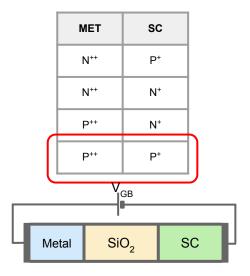


Datos: Poly-N⁺⁺ $N_{Bulk} = 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ $V_{T} = 0.547 \text{ V}$ $Y^{2} = 0.545 \text{ V}$ $C'_{OX} = 246 \text{ nF/cm}^{2}$





Datos: Poly-N⁺⁺ $N_{Bulk} = 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ $V_T = 0.547 \text{ V}$ $Y^2 = 0.545 \text{ V}$ $C'_{OX} = 246 \text{ nF/cm}^2$



Datos: Poly-N⁺⁺ $N_{Bulk} = 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ $V_{T} = 0.547 \text{ V}$ $V_{T}^{2} = 0.545 \text{ V}$ $V_{OX}^{2} = 246 \text{ nF/cm}^{2}$

GATE	SUBS	Φ _{Gate}	Ф _{Bulk}	V _{FB}	V _T
N ⁺⁺	N	+550mV	$0V < \Phi_{N} < 550 \text{mV}$	V _{FB} < 0V	$V_T < V_{FB} < 0V$
N ⁺⁺	Р	+550mV	-550mV < Φ _P < 0V	V _{FB} < 0V	$V_T > V_{FB}$
P++	N	-550mV	0V < Φ _N < 550mV	V _{FB} > 0V	$V_T < V_{FB}$
P**	Р	-550mV	-550mV < Φ _P < 0V	V _{FB} > 0V	V _T > V _{FB} > 0V

Datos: Poly-N⁺⁺ $N_{Bulk} = 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ $V_{T} = 0.547 \text{ V}$ $Y^{2} = 0.545 \text{ V}$ $C'_{OX} = 246 \text{ nF/cm}^{2}$

GATE	SUBS	Ф _{Gate}	Φ_{Bulk}	V _{FB}	V _T
N ⁺⁺	N	+550mV	0V < Φ _N < 550mV	V _{FB} < 0V	$V_T < V_{FB} < 0V$
N ⁺⁺	Р	+550mV	-550mV < Φ _P < 0V	V _{FB} < 0V	V _T > V _{FB}
P ⁺⁺	N	-550mV	0V < Φ _N < 550mV	V _{FB} > 0V	$V_T < V_{FB}$
P**	Р	-550mV	-550mV < Φ _P < 0V	V _{FB} > 0V	$V_T > V_{FB} > 0V$

Datos: Poly-N⁺⁺ $N_{Bulk} = 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ $V_{T} = 0.547 \text{ V}$ $V_{T}^{2} = 0.545 \text{ V}$ $V_{T}^{2} = 246 \text{ nF/cm}^{2}$

¿Cómo está compuesta la juntura?

Cómo V_T =0.547V (Positivo) => El sustrato es tipo P.

